

## 目 次

1	トップ・ダウンとボトム・アップの考え方	1
2	生活の仕方から出発した技術の強み	3
3	ICラボの役割	4
4	エレクトロニクスに寺田物理学の復権を	6
5	ICラインのトレーニング調整法	7
6	農業生産とICの工業生産	8
7	高級な工業生産としてのIC	9
8	初歩的な工業における日本とアメリカ	10
9	“Introduction to VLSI Systems ” のインパクト	11
10	工業化社会を成功させる条件 (1)	12
11	工業化社会を成功させる条件 (2)	13
12	工業化社会を成功させる条件 (3)	14
13	工業化社会を成功させる条件 (4)	15
14	工業化社会を成功させる条件 (5)	16
15	工業化社会を成功させる条件 (6)	17
16	工業化社会を成功させる条件 (7)	18
17	工業化社会を成功させる条件 (8)	19
18	工業化社会を成功させる条件 (9)	20
19	工業化社会を成功させる条件 (10)	21
20	工夫したウエハプロセス	22
21	厚い酸化膜から出発したnMOSプロセス	24
22	レジストのパターン流れ	26
23	石英管の洗浄とCV特性	27
24	P on Pエピ・ウエハとCMOS IC	29
25	プロセス管理におけるフィードバック	30

26	石英管内での治具の出し入れについて	32
27	パターンデータ格納方法の比較	33
28	プロセス制御のためのデータファイルの作成	35
29	テストMOSトランジスタのデータファイル	37
30	ブラウン管を用いた電子線描画装置(1)	39
31	ブラウン管を用いた電子線描画装置(2)	40
32	Siへの硼素拡散(1)	42
33	Siへの硼素拡散(2)	43
34	Siへの硼素拡散(3)	44
35	Siへの硼素拡散(4)	46
36	Siへの硼素拡散(5)	48
37	Siへの硼素拡散(6)	50
38	Siへの硼素拡散(7)	52
39	硼素拡散における表面濃度のくり込み計算	54
40	イオン注入した硼素の再分布によるPタブ形成	55
41	PSGからSiへの磷拡散(1)	57
42	PSGからSiへの磷拡散(2)	58
43	2電源インバータの特性(1)	59
44	2電源インバータの特性(2)	61
45	2電源インバータの特性(3)	63
46	2電源インバータの特性(4)	65
47	スタティックからダイナミックへ	67
48	パストラジスタを多用した フリップフロップ(1)	68
49	パストラジスタを多用した フリップフロップ(2)	70
50	パストラジスタを多用した フリップフロップ(3)	72

51	パストランジスタを多用した フリップフロップ (4) ……	74
52	パストランジスタを多用した フリップフロップ (5) ……	75
53	2ビット・スタティック・マイクロコンピュータ S L-M2003 ……	77
54	論理回路へのアナログ的要素の導入 ……	80
55	あいまいさを含んだ判断機能の導入 ……	81
56	しきい値変換回路 ……	82
57	多入力NORの出力電圧 ……	84
58	集積回路研究の方法 ……	86
59	ANDEXマシン (1) ……	87
60	ANDEXマシン (2) ……	89
61	ANDEXマシン (3) ……	91
62	ANDEXマシン (4) ……	93
63	ANDEXマシン (5) ……	94
64	ANDEXマシン (6) ……	95
65	ANDEXマシン (7) ……	96
66	ANDEXマシン (8) ……	97
67	ANDEXマシン (9) ……	98
68	PCGと並列分散処理への応用 (1) ……	99
69	PCGと並列分散処理への応用 (2) ……	100
70	PCGと並列分散処理への応用 (3) ……	102
71	PCGと並列分散処理への応用 (4) ……	104
72	PCGと並列分散処理への応用 (5) ……	106
73	PCGと並列分散処理への応用 (6) ……	108
74	PCGと並列分散処理への応用 (7) ……	110
75	PCGと並列分散処理への応用 (8) ……	112

76	PCGと並列分散処理への応用(9) .....	114
77	RBSによる結晶の評価(1) .....	116
78	RBSによる結晶の評価(2) .....	118
79	Si-BP-Si構造と各層のPMOSIC(1) .....	120
80	Si-BP-Si構造と各層のPMOSIC(2) .....	121
81	Si-BP-Si構造と各層のPMOSIC(3) .....	123
82	Si-BP-Si構造と各層のPMOSIC(4) .....	124
83	Si-BP-Si構造と各層のPMOSIC(5) .....	125
84	議論の場の有効利用 .....	126
85	約束を守る研究態度 .....	127
86	技術を組織立てるための教育 .....	128
87	研究グループにおける個人の役割 .....	129
88	形而上学とエンジニア .....	130
89	科学を創造するヨーロッパ .....	131
90	新しい工業を創造するアメリカ .....	132
91	高い生産性を可能にした日本 .....	133
92	研究成果の流れ .....	134
93	日本的な研究の成果 .....	135
94	人材の国際交流 .....	136
95	模倣の国の宿命 .....	137
96	大学の研究室の現実 .....	138
97	国立大学と私立大学 .....	139
98	国際交流をいかに進めるか .....	140
99	同じレールの上での競争 .....	141
100	エレクトロニクスの下部構造 .....	142

---

この文庫本は既刊の**エレクトロニクス文庫：超LSI時代の半導体技術 100集**〔I〕〔II〕〔III〕〔IV〕(庄野克房著)の続編になります。あわせてご利用ください。

(オーム社)

---